

DHA<sup>®</sup>

QJ/DHA 09.05-2018

2N60

## N-沟道 MOSFET 功率晶体管

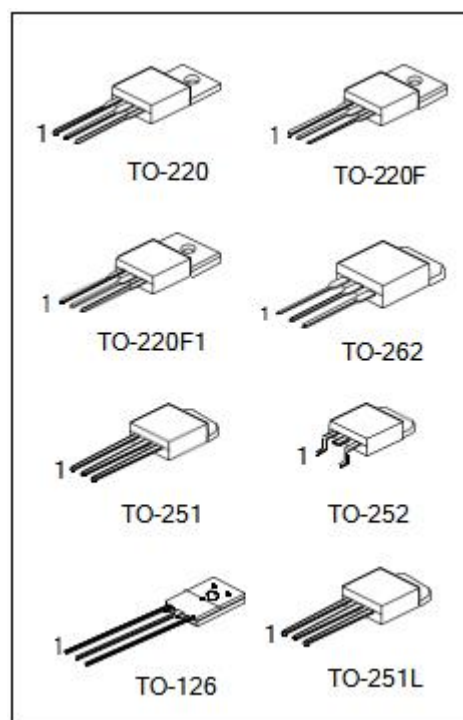
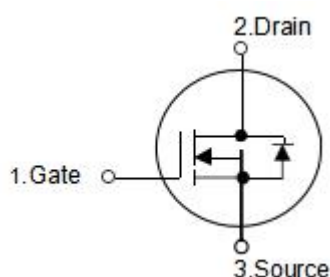
## 描述

2N60 是一款高压功率 MOSFET，具有更好的特性，例如快速开关时间，低栅极电荷，低导通电阻以及高耐用的雪崩特性。

## 用途

该功率 MOSFET 通常用于电源，PWM 电机控制，高效 DC-DC 转换器和桥接电路中的高速开关应用。

## 等效电路图



## 电参数 (Tamb = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV <sub>DSS</sub>	漏极-源极 击穿电压	V	600	-	-	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>D</sub>	漏极连续电流	A	-	-	1.8	T <sub>j</sub> = 25 °C
R <sub>DS(on)</sub>	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	4.0	5.0	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 0.9A
V <sub>GS(th)</sub>	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>DSS</sub>	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	10	V <sub>DS</sub> = 600 V, V <sub>GS</sub> = 0 V
I <sub>GSS</sub>	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V <sub>GS</sub> = ± 30 V, V <sub>DS</sub> = 0 V
T <sub>j</sub>	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	°C				